

**MACHETA nr.VIII**

**Contractor:**

**Cod fiscal :** (anexa la procesul verbal de avizare interna nr.....)

**De acord,**  
**DIRECTOR GENERAL**

**Avizat,**  
**DIRECTOR DE PROGRAM**

**RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI**

**Contractul nr. : PN16-480101**

**Proiectul :** Fenomene si procese fizico-chimice in sisteme nanometrice complexe, suprafete si interfete

**Faza nr. 5 :** Cartografierea la scala nanometrica a distorsiunilor structurale remanente in heterostructuri epitaxiale. Corelatii cu proprietatile electrice si magnetice ale heterostructurilor.

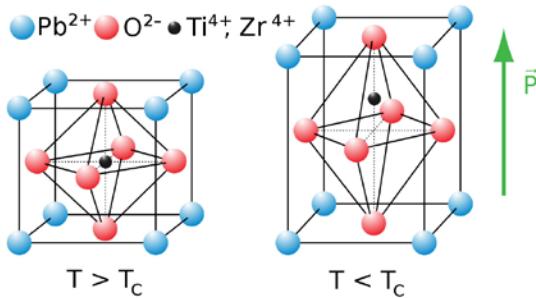
**Termen : 12.08.2016**

- 1. Obiectivul fazei** : determinarea distorsiunilor remanente in reteaua cristalina straturilor subtiri feroice si explorarea corelatiilor cu proprietatilor electrice si magnetice ale acestora.
- 2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei** : Punerea in evidenta a relaxarii retelei cristaline in vecinatarea interfetelor si a defectelor structurale in filme subtiri epitaxiale utilizand tehnici avansate de procesare digitala cantitativa a imaginilor de microscopie electronica de inalta rezolutie.

### 3. Rezumatul fazei :

## Introducere

Materialele oxidice cu proprietati feroice (e.g. PZT, BCZT, LSMO) sunt exemple tipice de materiale ale caror proprietati macroscopice sunt direct influente de structura cristalina a acestora si de posibilele distorsiuni microstructurale care pot aparea la scara nanometrica sub actiunea unor constrictii mecanice. Un exemplu la indemana pentru ilustrarea legaturii dintre structura atomica si proprietatile fizice macroscopice il reprezinta materialele cu proprietati feroelectrice (e.g.  $\text{Pb}(\text{Zr}_{1-x}\text{Ti}_{1-x})\text{O}_3$  sau PZT). PZT este un material ceramic cu structura de perovskit care in conditii de temperatura sub o valoare de prag  $T_c$ , sufera o tranzitie de faza structurala din faza cubica de temperatura inalta, intr-o faza tetragonală sau romboedrica (in functie de componetia Zr/Ti). La nivel macroscopic, aceasta tranzitie de faza se manifesta prin trecerea din faza paraelectrica asociata structurii cubice in faza feroelectrica data de structura necentrosimetrica tetragonală (sau romboedrica, in functie de  $x$ ) in care cationul tetravaent de  $\text{Ti}^{4+}$  sau  $\text{Zr}^{4+}$  este deplasat din centrul geometric al celulei cristaline de-a lungul axei [001] ducand la aparitia unui moment electric dipolar  $\mathbf{P}$  orientat paralel cu axa tetragonală  $c$  (figura 1).

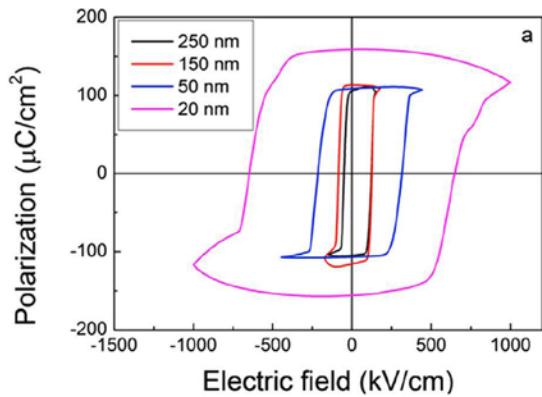


**Figura 1.** Reprezentarea grafica a celulei cristaline cubice a PZT in faza cubica de temperatura inalta ( $T > T_c$ ) si in faza tetragonală (dispunere necentrosimetrica a atomilor) la o temperatura sub valoarea temperaturii Curie ( $T < T_c$ ).

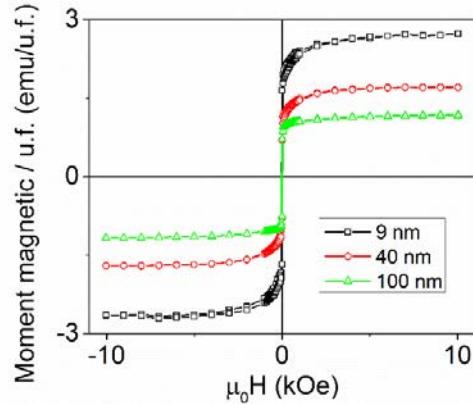
In cazul materialelor feromagnetice relatia dintre distorsiunile structurale si proprietatile magnetice este data de fenomenul de magnetostrictiune (modificarea formei sau dimensiunilor sub actiunea unui camp magnetic extern). Fenomenul este o consecinta a anizotropiei magnetocristaline si a tendintei de minimizare a energiei libere a sistemului aflat in camp magnetic prin modificarea peretilor de domenii feromagnetice si distorsionarea structurii cristaline in sensul reducerii unghiului dintre directia de usoara magnetizare si directia campului magnetic aplicat. In mod reciproc, aplicarea unei tensiuni mecanice asupra unui material feromagnetic are ca efect modificarea susceptibilitatii magnetice, fenomen cunoscut sub numele de efect magnetoelastic (sau efect Villari).

Studii recente au aratat o dependenta clara a proprietatilor fizice macroscopice ale filmelor subtiri multiferoice de grosimea acestora, precum variatia polarizarii electrice si a campului coercitiv cu grosimea straturilor subtiri de PZT (figura 2) [1], diminuarea magnetizarii de saturatie (exprimata ca moment magnetic pe unitatea de formula) odata cu cresterea grosimii filmelor subtiri de LSMO (figura 3), dependenta susceptibilitatii magnetice si a efectului magnetorezistiv de grosimea stratului in cazul LSMO [2], dependenta permitivitatii electrice a straturilor subtiri epitaxiale de BCZT de natura

substratului [3]. In toate aceste exemple este de asteptat ca relatia dintre proprietatile fizice la nivel macroscopic si cele microstructurale sa aiba la baza prezenta distorsiunilor structurale in straturile subtiri in interactie cu substratul, rezultate fie ca urmare a naturii substratului (nepotrivire a parametrului de retea) fie ca efect al grosimii stratului (procese de relaxare).



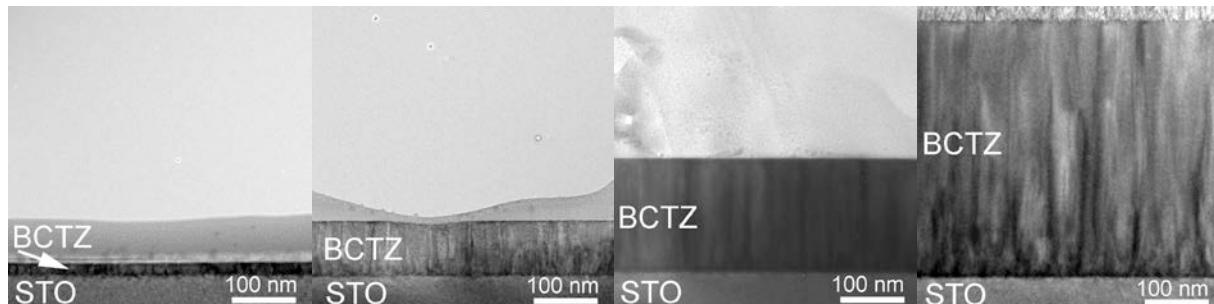
**Figura 2.** Curbe de polarizare electrică în straturi subtiri epitaxiale de PZT cu grosimi între 20 și 250 nm [1].



**Figura 3.** Curbe de magnetizare la temperatură camerei pe probe de filme subtiri de LSMO cu grosimi de 9 nm, 40 nm și 100 nm. Sunt considerate momentele magnetice pe unitatea de formula (u.f.).

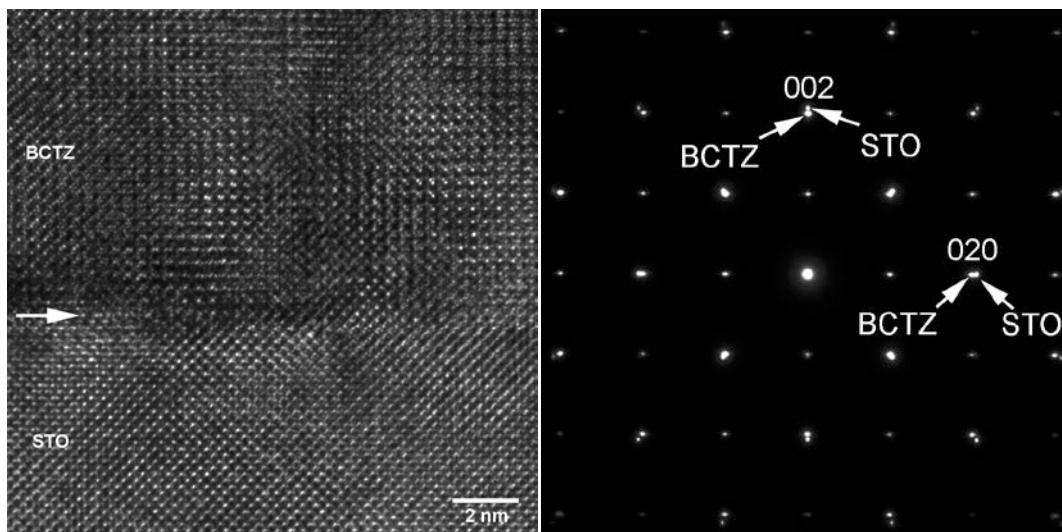
Acesta faza de proiect s-a concentrat pe realizarea unui studiu privind evaluarea cantitativa a distorsiunilor structurale remanente în straturi subtiri epitaxiale din materiale cu proprietăți multiferoice și cartografiere la scala nanometrică a acestor distorsiuni în încercarea de a stabili o corelație între valoarea acestor distorsiuni, grosimea straturilor subtiri depuse precum și comportamentul acestor distorsiuni în structuri complexe, multistrat. În acest sens au fost examineate două sisteme de straturi subtiri epitaxiale cu grad de complexitate crescător: straturi simple de BCZT (Ba-Ca-Zr-Ti-O) crescute epitaxial pe substrat de SrTiO<sub>3</sub> (STO) și straturi bi-strat de PZT/SRO crescute epitaxial pe STO. Straturile au fost depuse prin tehnica depunerii laser pulsate (PLD) și analizate din punct de vedere morfo-structural prin microscopie electronică de înaltă rezoluție prin transmisie (HRTEM) folosind microscopul electronic JEM ARM 200F și procesare cantitativa a imaginilor HRTEM folosind metoda Analizei Fazei Geometrice (GPA) [4]

In figura 4 este prezentata seria de straturi subtiri de BCZT avand compozitia nominala  $[Ba(Ti_{0.8}Zr_{0.2})O_3]_{(1-x)} - [(Ba_{0.7}Ca_{0.3})TiO_3]_x$ , cu  $x = 0.45$  (sau BCZT 45). Filmele de BCZT depuse prin tehnica PLD au grosimi de 20, 85, 175 respectiv 340 nm. Imaginile de microscopie electronică prin transmisie (TEM) înregistrate la marire mică pe probe preparate în secțiune transversală (figura 4) arată o creștere columnară a filmelor de BCZT, cu o grosime uniformă și rugozitate scăzută. Se observă un contrast de difracție care indică acumularea de tensiuni mecanice în zona interfetei cu substratul, dar și la contactul dintre grauntii cristalini ai filmului de BCZT. Mecanismul de creștere sugerat de contrastul de difracție este unul mixt de tip Strasnski-Krastanov (creștere sub formă de insule combinat cu creștere de tip strat cu strat).



**Figura 4.** Serie de straturi subtiri de BCTZ cu grosime crescatoare (20 nm, 85 nm, 175 nm, 340 nm) depuse epitaxial pe substrat monocristalin de STO(001).

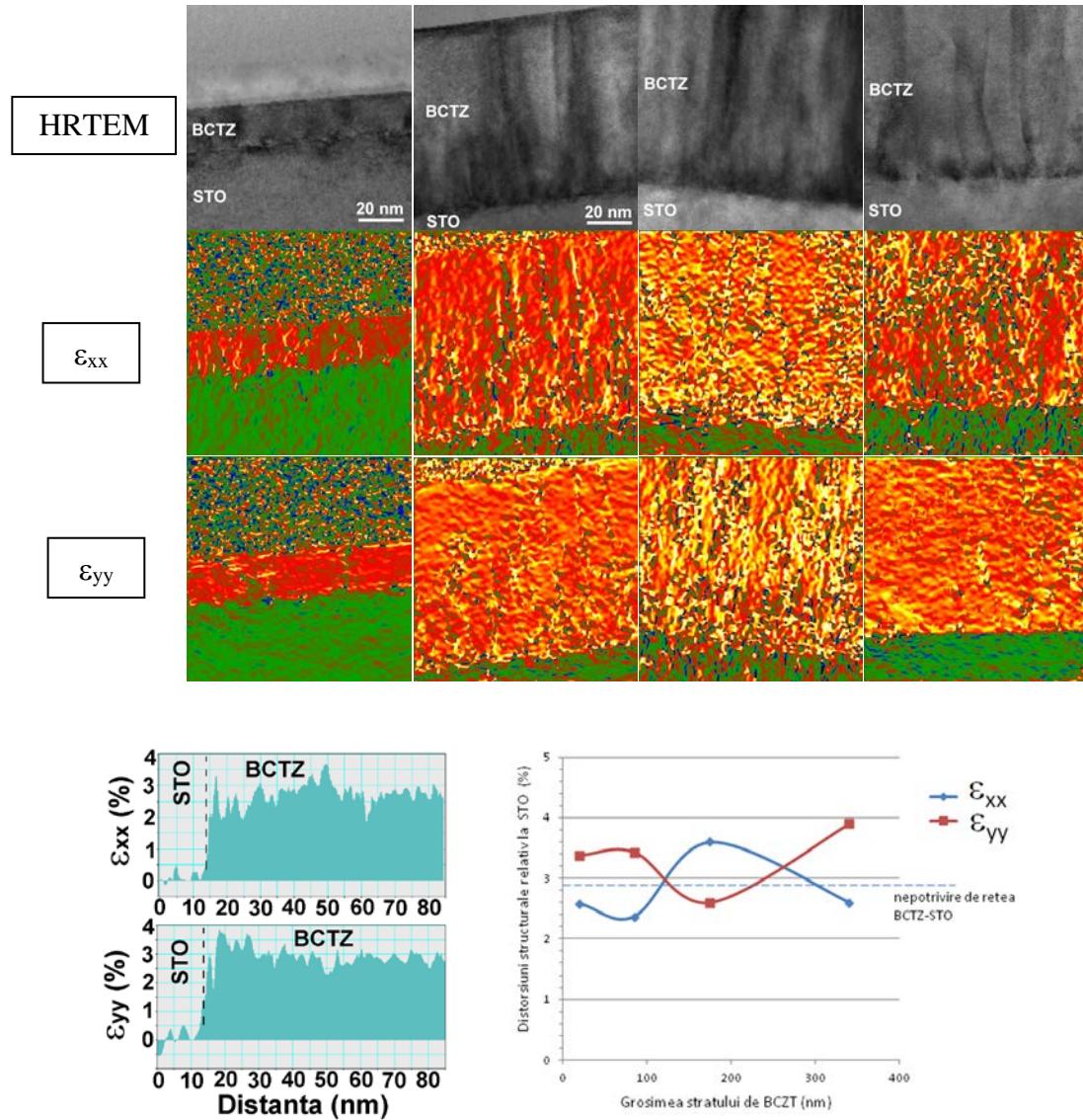
In diagrama de faza binara  $(1 - x)\text{Ba}(\text{Zr}_{0.2}\text{Ti}_{0.8})\text{O}_3 - x(\text{Ba}_{0.7}\text{Ca}_{0.3})\text{TiO}_3$  structura cristalina corespunzatoare compozitiei cu  $x=45$  este una tetragonală la temperatura camerei, apartinând grupului spatial P4mm, cu o constantă de rețea pseudocubică  $a_p=0.40176$  nm [3, 5]. Substratul de  $\text{SrTiO}_3$  utilizat prezintă o structură cubică cu un parametru de rețea  $a_{\text{STO}}=0.3905$  nm. Nepotrivirea de rețea între cele două structuri este de  $(a_p - a_{\text{STO}})/a_{\text{STO}}=2.88\%$ , ceea ce favorizează creșterea epitaxială a stratelor subtiri de BCZT pe substrat STO(001). Creșterea epitaxială a filmelor subtiri de BCZT/STO(001) este demonstrată atât prin difracție de electroni pe arie selectată cât și prin imaginile HRTEM la interfața film-substrat (figura 5). Prezența distorsiunilor microstructurale la nivelul interfeței este evidențiată de variațiile de contrast în imaginea HRTEM.



**Figura 5.** Imagine HRTEM tipică la interfața dintre stratul subtire de BCTZ și substratul de STO care arată creșterea epitaxială a filmului subtire. Difracțogramă de electroni pe arie selectată în zona interfeței care confiră creșterea epitaxială a filmului de BCTZ și ilustrează prin dublarea spoturilor de difracție diferența de rețea între film și substrat.

Analiza cantitativă a distorsiunilor structurale în filmele subtiri de BCZT precum și cartografierea acestora s-a facut aplicând o tehnică avansată de procesare în spațiu Fourier a imaginilor HRTEM obținute pe filmele subtiri analizate, denumita Analiza de Faza Geometrică. În acest scop au fost achiziționate imagini HRTEM ale filmelor subtiri

de BCZT in vecinatatea interfetei cu substratul de STO. Probele au fost orientate de-a lungul directiei cristalografice [100]STO a substratului de STO care a fost considerat ca si referinta in evaluarea distorsiunilor structurale in filmele subtiri de BCZT.



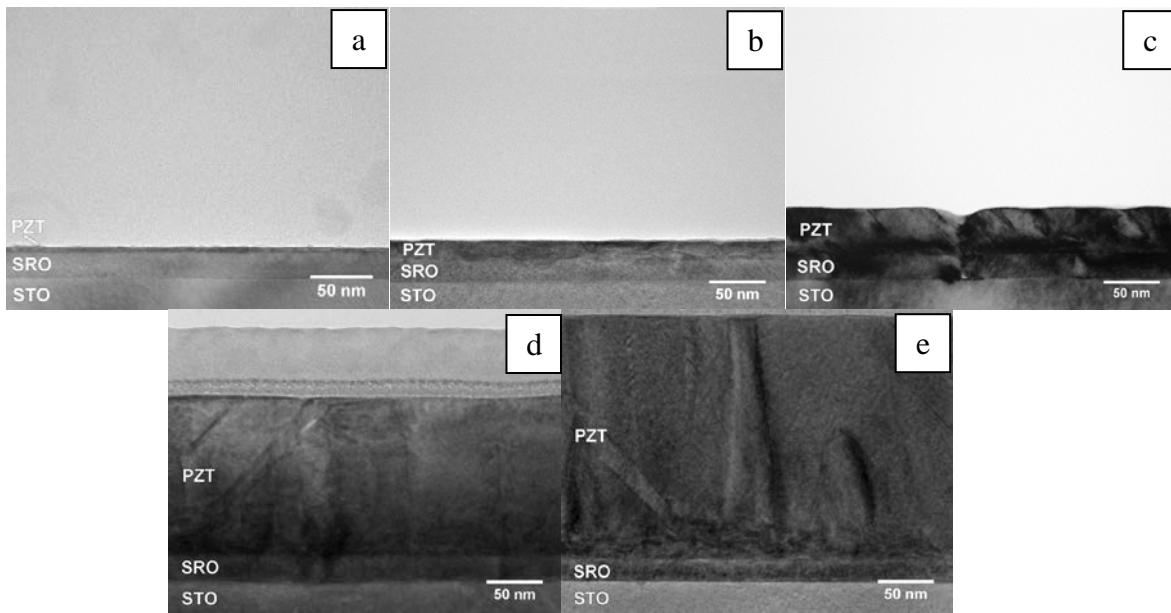
**Figura 6.** Evaluarea cantitativa si cartografia distorsiunilor structurale relative  $\varepsilon_{xx}$  si  $\varepsilon_{yy}$  in filmele subtiri de BCZT in raport cu substratul de STO luat ca referinta, folosind tehnica GPA aplicata imaginilor HRTEM prezentate pe primul rand al matricii de imagini. Profil liniar al distorsiunilor structurale  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$  in vecinatatea interfetei dintre stratul de BCZT cu grosimea de 85 nm si substratul de STO. Valorile  $\varepsilon_{xx}$  si  $\varepsilon_{yy}$  mediate pe intreaga grosime a filmelor de BCZT din imagini sunt prezentate in graficul alaturat.

Cartografiile reprezentate in culori false sub imaginile HRTEM corespunzatoare (figura 6) prezinta in general o deformare de intindere ( $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy} > 0$ ) a retelei cristaline corespunzatoare filmului subtire de BCZT (culoare galben-rosu) in raport cu substratul de STO luat ca referinta (fond preponderent verde). Profilul liniar al distorsiunilor structurale  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$  in stratul de BCZT cu grosimea de 85 nm prezinta valorile numerice

ale acestor distorsiuni de-a lungul unei directii perpendicular pe interfata, trecand din substratul de STO luat ca referinta (valori medii nule ale distorsiunilor) in volumul stratului de BCZT. Valorile numerice ale distorsiunilor (disponibile in fiecare pixel al imaginilor) au fost mediate pe intreaga grosime de film BCZT disponibila in imaginile HRTEM si reprezentate grafic in functie de grosimea filmului de BCZT. Se constata un comportament complementar al curbelor distorsiunilor  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$  in functie de grosimea filmului in cazul deformarilor paralele cu interfata respectiv perpendicular pe interfata. Aceste valori sunt raportate la reteaua substratului de STO luat ca referinta. Raportarea la reteaua nedeformata a BCZT se poate face comparand aceste valori cu nepotrivirea de retea dintre STO si BCZT, reteaua BCZT avand un parametru pseudocubic cu 2.88% mai mare decat STO. Linia punctata de pe grafic este pozitionata la acest nivel. Desi, data fiind diferentea dintre parametrii de retea ai celor doua structuri, substratul de STO exercita o actiune compresiva asupra filmului de BCZT, se observa comportamentul oscilant si complementar al curbelor deformarilor relative  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$  in filmul de BCZT de o parte si de alta a liniei punctate, indicand faptul ca ***natura distorsiunilor depinde de grosimea filmului, dependenta nefiind una monotonă***. Valorile  $\varepsilon_{xx}$ ,  $\varepsilon_{yy}$  mai mari decat 2.88% indica o deformare de intindere pe directia respectiva, paralel, respectiv perpendicular pe interfata, in timp ce valorile mai mici decat 2.88% indica o comprimare a retelei BCZT pe directiile mentionate. Complementaritatea celor doua curbe este in perfect acord cu efectul Poisson din teoria elasticitatii conform caruia deformarea axiala a unui material induce o deformare de semn opus pe celelalte doua directii transversale. Variatia naturii si valorilor numerice a distorsiunilor structurale cu grosimea filmelor subtiri indica o ***dependenta complexă***, in care nepotrivirea de retea intre film si substrat este numai ***un*** factor.

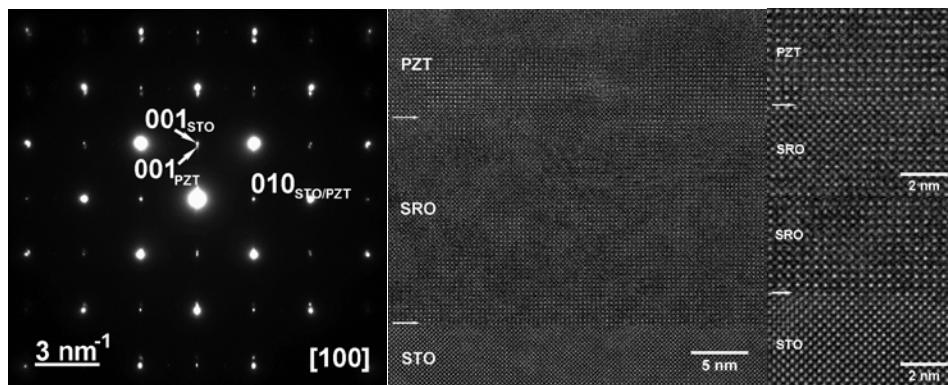
Un studiu similar a fost desfasurat pe o structura mai complexa, implicand doua straturi subtiri epitaxiale, PZT si SrRuO<sub>3</sub> (sau SRO), depuse pe acelasi tip de substrat, STO (001). Seria de probe studiata a constat in straturi de PZT cu grosimi crescatoare (5, 20, 50, 150, 250 nm) depuse peste un strat tampon de SRO mentinut la o grosime constanta de 20 nm.

Imaginiile TEM inregistrate la marire mica pe probe preparate in sectiune transversala (figura 4) arata o crestere compacta a filmelor de SRO si PZT, cu o grosime uniforma si rugozitate scazuta. Contrastul de difractie indica acumularea de tensiuni mecanice in special in zona interfetei PZT-SRO. Constantele de retea ale celor 3 materiale sunt  $a_{STO}=0.3905$  nm,  $a_{SRO}=0.394$  nm (aproximatie pseudocubica), cu 1% mai mare decat  $a_{STO}$  si  $a_{PZT}=b_{PZT}=0.3950$  nm,  $c_{PZT}=0.4150$  nm, ceea ce favorizeaza o crestere a structurii tetragonale a PZT cu axul tetagonal *c* orientat perpendicular pe interfata. Incepand de la grosimi de ordinul 50 nm, filmele de PZT prezinta ***domenii structurale*** precum si ***dislocatii*** cu originea in zona interfetei cu SRO care fie traverseaza intreg filmul (threading dislocations) fie formeaza bucle in interiorul filmului de PZT. Mecanismul de crestere sugerat de imaginile TEM in sectiune transversala ale filmelor cu grosimi mici (5-20 nm) este unul de tip Frank-van der Merwe (strat cu strat).



**Figura 7.** Serie de straturi subtiri de PZT/SRO/STO cu grosime crescatoare a stratului piezoelectric de PZT : 5 nm, 20 nm, 50 nm, 150 nm, 250 nm. Grosimea stratului de SRO: 20 nm.

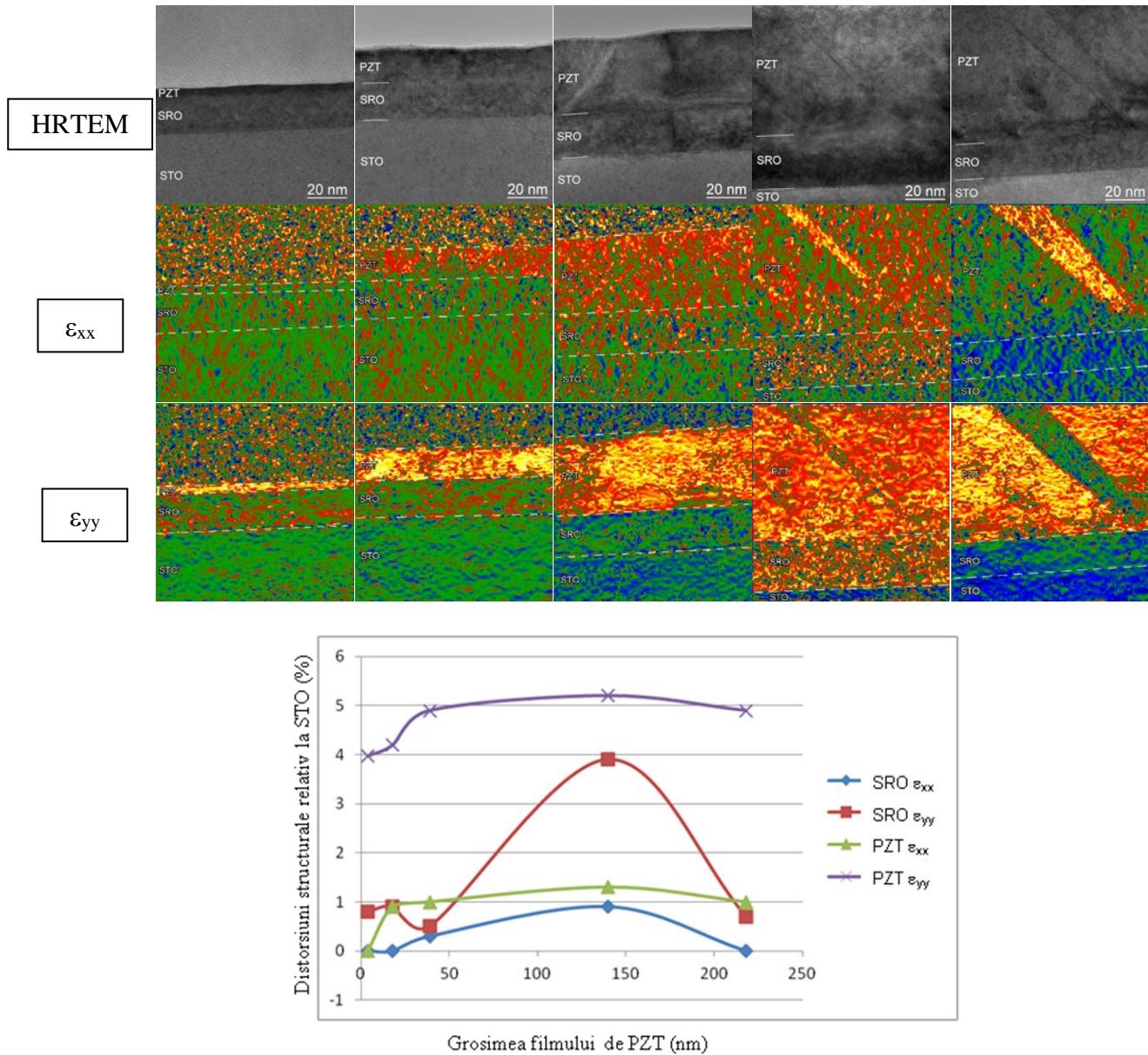
Cresterea epitaxiala a filmelor de SRO si PZT pe substratul de STO (001) este demonstrata atat de difractogrammele de electroni pe arie selectata cat si de imaginile HRTEM la interfetele SRO-STO si PZT-SRO (figura 8) care evidentaaza cresterea PZT cu structura tetragonală intr-o orientare cristalografica in raport cu substratul descrisa de  $[100]_{\text{PZT}} \parallel [100]_{\text{STO}}$  si  $[001]_{\text{PZT}} \parallel [001]_{\text{STO}}$ .



**Figura 8.** Difractogramma de electroni pe arie selectata (SAED) in zona interfetei care confirma cresterea epitaxiala a filmelor de SRO si PZT. Dublarea spoturilor de difractie indica diferenta de parametru de retea intre straturi si substrat. Imagine HRTEM care confirma cresterea epitaxiala a filmelor subtiri (interfetele sunt indicate cu sageti albe) si detalii de la interfetele SRO-STO si PZT-SRO.

Masurarea si cartografirea campului de distorsiuni structurale in filmele de SRO si PZT s-a facut folosind aceeasi tehnica de procesare cantitativa a imaginilor HRTEM, metoda GPA. Distributia 2D a campului de distorsiuni pentru intreaga serie de probe este prezentata in figura 9 sub forma de culori false luand substratul de STO ca referinta.

Valorile numerice ale deformarilor structurale in raport cu substratul de STO, mediate pe intreaga suprafata a filmelor de SRO si PZT disponibila in imaginile HRTEM sunt prezentate in graficul alaturat. In cazul filelor de PZT care prezinta domenii structurale (macle), medierea s-a facut numai pe arii monodomeniu, evitandu-se benzile de maclaj.



**Figura 9.** Evaluarea cantitativa si cartografia distorsiunilor structurale relative  $\varepsilon_{xx}$  si  $\varepsilon_{yy}$  in filmele subtiri de SRO si PZT in raport cu substratul de STO luat ca referinta, folosind tehnica GPA aplicata imaginilor HRTEM prezentate pe primul rand al matricii de imagini. Valorile  $\varepsilon_{xx}$  si  $\varepsilon_{yy}$  mediate pe intreaga grosime a filmelor de SRO si PZT din imagini sunt prezentate in graficul alaturat.

Ca si in cazul anterior, se poate constata o dependenta complexa a distorsiunilor remanente in SRO si PZT in functie de grosimea filmelor de PZT. Interactia dintre cele

doua straturi subtiri in prezenta substratului precum si procesele de relaxare elastica cu formarea de dislocatii si domenii structurale in PZT face ca alura curbelor sa nu mai fie la fel de simetrica precum in cazul BCZT/STO. Curbele pastreaza inca un comportament preponderent nemonoton, cu variatii mari in special in cazul filmelor foarte subtiri (5-20 nm). O crestere spectaculoasa a valorilor deformarilor relative  $\epsilon_{xx}$  si  $\epsilon_{yy}$  se observa in cazul filmului de SRO cu grosimea de 150 nm. Toate curbele pastreaza insa o forma care contine un minim in domeniul de grosimi mici urmat de un maxim si de o zona de relaxare in domeniul de grosimi mari.

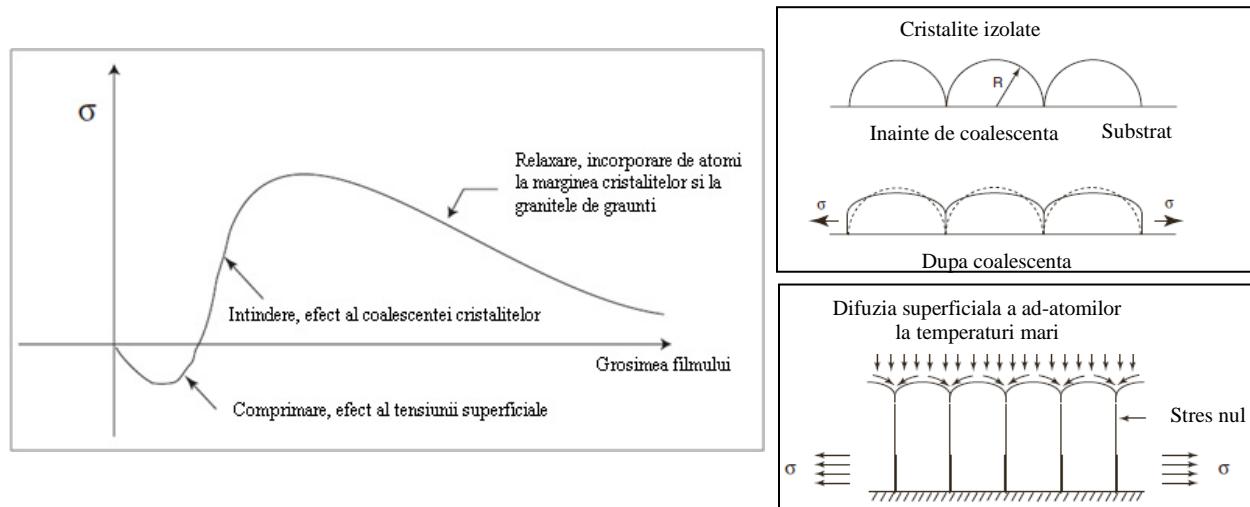


Figura 10. Dependenta tensiunii medii intr-un film subtire in functie de grosimea filmului si modele asociate de crestere a filmelor subtiri [6].

Dependentetele evidente in studiile noastre sunt in concordanta cu modelul teoretic descris de Joost Vlassak care prezinta evolutia tensiunilor mecanice din filmele subtiri in functie de grosimea acestora [6] precum si cu datele experimentale prezentate de R. Koch et al. privind cresterea filmelor policristaline de Ag [7]. Conform acestui model, in fazele incipiente ale cresterii filmelor (grosimi mici), cristalitele care se formeaza pe suprafata substratului se afla pe de o parte sub influenta stresului compresiv ( $\sigma < 0$ ) din partea substratului (atunci cand parametrul de retea al substratului este mai mic decat al filmului,  $a_s < a_f$ ) si pe de alta parte sub actiunea fortelelor de tensiune superficiala care creeaza de asemenea o deformare compresiva in interiorul cristalitului ( $a_{cristalit} < a_{film}$ ). In faza urmatoare a cresterii are loc coalescenta cristalitelor care ajung sa intre in contact. Fortele de coeziune care se manifesta intre cristalitele aflate in contact induc o deformare de intindere ( $\sigma, \epsilon > 0$ ) in interiorul cristalitelor [8]. Continuarea procesului de crestere a filmului subtire prin adaugarea de noi atomi pe suprafata si difuzia acestora spre granitele dintre graunti (daca depunerea are loc la temperaturi suficient de ridicate pentru a asigura mobilitatea superficiala a atomilor) duce la unificarea cristalitelor si relaxarea tensiunilor de intindere. Tensiunile elastice ar ramane astfel concentrate in vecinatarea interfetei cu substratul, in perfect acord cu observatiile noastre TEM (e.g. figura 7e).

## Referinte

- [1] L. Pintilie, C. Ghica, C. M. Teodorescu, I. Pintilie, C. Chirila, I. Pasuk, L. Trupina, L. Hrib, A. G. Boni, N. G. Apostol, L. E. Abramiuc, R. Negrea, M. Stefan, D. Ghica, *Scientific Reports* **5**, 14974 (2015)
- [2] S. Chromik, V. Strbík, E. Dobrocka, A. Dujavová, M. Reiffers, J. Liday, M. Spanková, *Applied Surface Science* **269**, 98– 101 (2013)
- [3] N. D. Scarisoreanu, F. Craciun, A. Moldovan, V. Ion, R. Birjega, C. Ghica, R. F. Negrea, M. Dinescu, *ACS Appl. Mater. Interfaces* **7**, 23984–23992 (2015)
- [4] M. J. Hýtch, J.-L. Putaux, and J.-M. Pénisson, *Nature* **423**, 270 (2003).
- [5] D. S. Keeble, F. Benabdallah, P. A. Thomas, M. Maglione, J. Kreisel, *Applied Physics Letters* **102**, 092903 (2013)
- [6] J. J. Vlassak, Thin Film Mechanics, Harvard University, Boston, MA (2004).
- [7] R. Koch, D. Winau, K. H. Rieder, *Physica Scripta* **T49**, 539-543 (1993).
- [8] L. B. Freund, E. Chason, *Journal of Applied Physics* **89**, 4866 (2001)

#### 4. Rezultate, stadiul realizarii obiectivului, concluzii si propuneri pentru continuarea proiectului :

Obiectivele prezentei faze au fost indeplinite integral. S-au utilizat **tehnici avansate de sinteza si caracterizare microstructurala** a materialelor pentru a evidenta corelatia dintre proprietatile structurale la scara nanometrica si proprietatile fizice la scara macroscopica:

- Au fost realizate serii de probe sub forma de straturi subtiri epitaxiale prin depunere laser pulsata
- Probele au fost analizate prin microscopie electronica de inalta rezolutie (HRTEM) in sectiune transversala
- Imaginele HRTEM au fost procesate prin tehnici de procesare de imagine de ultima ora (Analiza de Faza Geometrica) pentru a extrage informatii cantitative privind distorsiunile structurale reziduale si cartografiere la scara nanometrica a campului de distorsiuni microstructurale in filmele subtiri epitaxiale.
- Au fost analizate datele experimentale in conformitate cu modelele teoretice existente privind cresterea straturilor subtiri si evolutia tensiunilor reziduale in functie de grosimea filmelor.

Rezultatele obtinute deschid perspective noi privind continuarea investigatiilor de acest gen. Pe de o parte, din punct de vedere experimental, ar fi utila completarea datelor TEM obtinute pana in acest moment cu informatii suplimentare obtinute din regiuni diferite ale probelor TEM investigate, regiuni cu grosimi de lamela TEM diferite, pentru a verifica consistenta informatiilor cantitative obtinute in legatura cu posibila relaxare a sistemului in regiunile cele mai subtiri ale lamelei TEM. Pe de alta parte, data fiind limitarea spatiala a investigatiilor HRTEM desfasurate la distante de pana la 90 nm fata de interfata cu substratul, ar fi utila extinderea domeniului de grosimi investigate prin cartografierea in-situ a campului de distorsiuni folosind tehnici de difractie de electroni cu precesie, fie prin achizitionarea unui sistem de acest gen in cadrul INCDFM fie prin organizarea unor experimente in cadrul unor laboratoare dotate cu aceasta infrastructura. In al treilea rand, pentru stabilirea unor corelatii cat mai stranse intre procesele la nivel microstructural si proprietatile fizice macroscopice, se vor efectua modelari folosind platforma Comsol achizitionata in cadrul proiectului Nucleu. Rezultatele obtinute au fost prezentate in cadrul celei de a 6-a editii a International Conference on NANOstructures and nanomaterials Self-Assembly NanoSEA 2016 organizata in perioada 3-8 Iulie la Giardini Naxos, Italia si sunt in curs de editare in cadrul a doua manuscrise ce vor fi trimise la publicare in jurnale ISI.

Responsabil faza proiect,  
Dr. Cornelius Ghica